垂直配向単層カーボンナノチューブ膜を接着した 高温加熱面と液滴間の伝熱特性

Heat Transfer of liquid droplets impinging on vertically aligned SWNTs film bonded to a heated metal surface.

伝正	*渡辺	誠	(東大工)		関根	哲彦	(神奈川大)
	福富	隆弘	(神奈川大)	伝学	石川	桂	(東大工)
伝正	丸山	茂夫	(東大工)	伝正	庄司	正弘	(神奈川大)

Makoto WATANABE¹, Akihiko SEKINE², Takahiro FUKUTOMI², Kei ISHIKAWA¹, Shigeo MARUYAMA¹ and Masahiro SHOJI²

¹Dept. of Mech. Eng., The Univ. of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

²Dept. of Mech. Eng., Kanagawa Univ., 3-27-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 221-8686

By using a vertically aligned single-walled carbon nanotubes (VA-SWNT) film as a heat transfer surface, the phase change phenomena were investigated. The VA-SWNT film serves as a surface with super-water-repellency and large thermal conductivity. The VA-SWNT film was bonded to a copper block to construct a high-temperature heating surface. Liquid droplets were impinged onto the high temperature heating surface and the behavior of the liquid droplets was observed with a high-speed video camera. By measuring the heat transfer characteristics, the surface of the VA-SWNT film was compared with conventional copper surfaces.

Key Words : Single-walled carbon nanotubes, Vertical alignment, Bonding, Liquid droplets impinging

1. 緒言

我々のグループは以前,炭素源としてアルコールを用いる ことで,高純度 SWNT のバルク合成が可能となることを見 出した^(1,2).これと Co/Mo 混合酢酸塩溶液を用いたディップ コート触媒担持法とを組み合わせることで,シリコンや合成 石英などの平滑基板上への SWNT 直接生成法が開発された ^(3,4).さらに,CVD 中の触媒活性を高めることにより,基板 表面に垂直配向した SWNT 膜(VA-SWNT 膜)が成長可能 であることが見出された^(5,6,7).

最近では,接触角が145度以上という非常に高い撥水性を 有することを見出して,この膜を簡単に剥離して,再付着さ せる技術が確立した^(8,9).また,カーボンナノチューブが有 する高熱伝導性を利用して,電子部品,機器等の冷却性能向 上が期待できると着想した.

そこで、VA-SWNT 膜と金属面との強固な接着を試みた. VA-SWNT 膜に真空蒸着によって金薄膜を形成し、金薄膜面 を他の金属ブロック面と接触させて、あるいはろう材を間に 挟み込んで、高温でのアニールを行うことでの強固な接着に 成功した^(10,11).

本報では、超撥水性や大きな熱伝導率や表面微細構造を有 する VA-SWNT 膜を伝熱面とし、その高温加熱膜面上に、一 個の液滴あるいは液滴列を衝突させたときの液滴の挙動を 高速度ビデオカメラにより観察し、あるいは伝熱特性につい て測定することで、従来の銅表面と VA-SWNT 膜表面とを比 較したので報告する.

2. 加熱面の製作

アルコール CVD 装置で石英基板上に Fig.1 に示すような VA-SWNT 膜を生成する.その後,真空蒸着装置内の基板加 熱器で VA-SWNT 膜の温度を約 300℃の高温に保ちながら金 を 100nm 蒸着した.

金微粒子が VA-SWNT 膜の内部に 1µm ほどの深さまで浸

第45回日本伝熱シンポジウム講演論文集 (2008-5)

入し,バンドル同士の隙間に入り込んでいるのが見られ,表面には金が堆積し,しっかり付着している.

Fig.2(a)に示すような実験装置を試作し, 試料をチャンバー 内部に Fig.2(c)のように伝熱ブロックと(金蒸着 VA-SWNT 膜+石英基板)の間にろう材を挟みこみ,石英円筒管の中央 にセットし,上方より0.35MPa 程度の圧力で基板を押し付け ながら,アルゴンガスを流しながら還元雰囲気中において, Fig.2(b)に示すヒーターでアニール温度を750℃に設定した.



Fig. 1. A typical SEM image of the VA-SWNT film grown on a quartz substrate.



(a) Prototype (b) Heater (c) Arrangement Fig. 2. Experimental apparatus.



Fig. 3. Photos of (a) a VA-SWNT film connected to a heat transfer block, and (b) the experimental setup.



Fig. 4. Droplet impingement experimental apparatus.

Fig.3(a)のように、銅円柱端面へ膜を強固に接着し、これを Fig.3(b)の断熱ブロックと共に Fig.4 の実験装置にセットした.

4. 高温加熱面上への液滴衝突の実験方法

Fig.4 に液滴衝突実験装置を示す.実験は大気圧下で行い, アルゴンガスを循環させた.テスト部はφ10mmの銅円柱に VA-SWNT 膜を接合した面,および比較のため銅円柱面の2 種類で行った.20℃に保った水を冷却液滴に用いて,ダイア フラムバルブで流量制御し,ニードルから吐出を行ったが, 流量を一定に保ちつつ加熱面に液滴を衝突させた.加熱面を 始め320℃に加熱し,次に液滴を衝突させ冷却を開始する非 定常実験とした.加熱円柱の温度変化は,テスト部の中心軸 上に表面からの深さ2,4,6mmの位置に設置したK型熱電 対で測定し,デジタルレコーダーによってサンプリング周波 数を1Hz で記録した.液滴の挙動は,高速度ビデオカメラ (1000 コマ/秒)で撮影した.今回の実験では,流量Qをパ ラメタにとり,Q=0.1~1.8g/minの範囲で変化させた.

5. 結果及び考察

5.1 液滴での冷却特性

① 低流量域 (Fig.5 (a)) Q=0.1~0.2g/min においては,銅面 に比べて, VA-SWNT 膜面での超撥水性に基づいた液滴の反 発が顕著であり、ライデンフロスト現象も観察され、あまり 冷却に寄与しなかったと思われる.

② 中流量域 (Fig.5 (b)) Q=0.5~0.6g/min においては, VA-SWNT 膜面の温度降下が銅面よりも顕著である.特に, 伝熱面の温度が 200~100℃までの温度領域において,その差 は明らかである.これは,我々も予想しなかった結果であり, とても興味深い.原因の一つとして,VA-SWNT 膜は, 膜面 に垂直な方向に熱伝導率が高く,水平な方向に低い特徴を持 っているので,液滴を加熱表面の中心部分に衝突させた今回 の実験では,銅円柱の中心軸方向に冷却が速く進んだ為と考 えられる.これに対し銅表面の場合は,どの方向にも一様な

③ 高流量域 (Fig.5 (c)) Q=1.5~1.8g/min においては, 銅面 と VA-SWNT 膜面を比較しても,変化は見られなかった.

5.2 液滴の挙動

冷却過程における衝突液滴が,非ぬれ領域,ぬれ領域にお いて分裂,収縮,反発などの挙動を高速度ビデオカメラを用 いて撮影した.画像は、口頭発表時に示す.



Fig. 5. Cooling characteristics of the heat transfer surface.

6. まとめ

超撥水性や大きな熱伝導率や表面微細構造を有する垂直 配向単層カーボンナノチューブ膜を伝熱加熱面に接着でき た.液滴の衝突実験に充分耐用できるほど,強固に接着でき たことが確認された.この膜面を使用することで伝熱促進す るのか,あるいは阻害されるのかは現段階では,不明ではあ るが,伝熱実験に充分耐え得ることが確認できたことは意義 あることである.また,この膜面に液滴を衝突させて冷却特 性と液滴の挙動を観察したところ,中流量域において我々が 予想しなかったとても興味深い結果が得られたので,今後そ の周辺を集中的にデータの収集と検討を進める.

参考文献

- (1) S. Maruyama et. al., Chem. Phys. Lett. 360 (2002), 229.
- (2) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. 374 (2003), 53.
- (3) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. 377 (2003), 49.
- (4) Y. Murakami et. al., Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004), 1221.
- (5) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. **385** (2004), 298.
- (6) S. Maruyama et. al., Chem. Phys. Lett. 403 (2005), 320.
- (7) Y. Murakami et. al., Carbon. 43 (2005), 2664
- (8) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett., **422** (2006), 575.
- (9) 渡辺·他4名,第43回日本伝熱シンポジウム, 1(2006),193.
- (10) 渡辺・他 5 名,第 44 回日本伝熱シンポ ジウム, 3 (2007), 615.
- (11) 渡辺・他 5 名,第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム, (2007), 183.
- (12) 庄司·他2名,日本機械学会論文集(B),50-451 (1984),716.